



3. 規格

3-1 絶対最大定格(周囲温度 25°C)
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

項目	記号	Symbol	定格	単位
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE}	V_{CE}	-160	V
コレクタ-ベース電圧	V_{CBO}	V_{CBO}	-160	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE}	V_{CE}	-160	V
エミッタ-ベース電圧	V_{EBO}	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	I_C	-15	A
ベース電流	I_B	I_B	-1	A
許容損失	P_C	P_C	150 (Tc=25°C)	W
ダイオード順方向電流	DIF	DIF	10	mA
接合部温度	T_J	T_J	150	°C
保存温度	T_{sig}	T_{sig}	-55~+150	°C

3-2 電氣的特性(周囲温度 25°C)
Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項目	記号	Symbol	条件		
			MIN	TYP	MAX
最大コレクタ遮断電流	I_{CBO}	I_{CBO}	$V_{CB}=-160V, I_E=0A$		-100 μA
最大エミッタ遮断電流	I_{EBO}	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_C=0A$		-100 μA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	V_{CEO}	$I_C=30mA$	-160	V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	h_{FE}^*	$V_{CE}=4V, I_C=10A$	5000	20000
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10A, I_B=10mA$		-2.0
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$V_{BE(sat)}$	$I_C=10A, I_B=10mA$		-2.5
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{BE}	$V_{CE}=-20V, I_C=40mA$	1200	
ダイオード順方向電圧	DIF	DIF	$I_F=2.5mA$	1540	
エミッタ抵抗	R_E	R_E	$I_E=1A$	0.176	0.264

* h_{FE} mark 5000-12000(O), 8000-20000(Y)

※ T_r をへて使用する場合は以下の条件を満足すること。

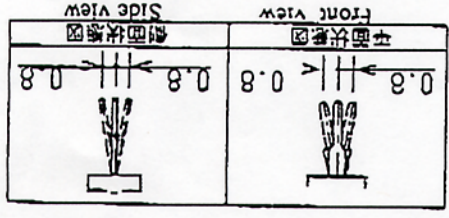
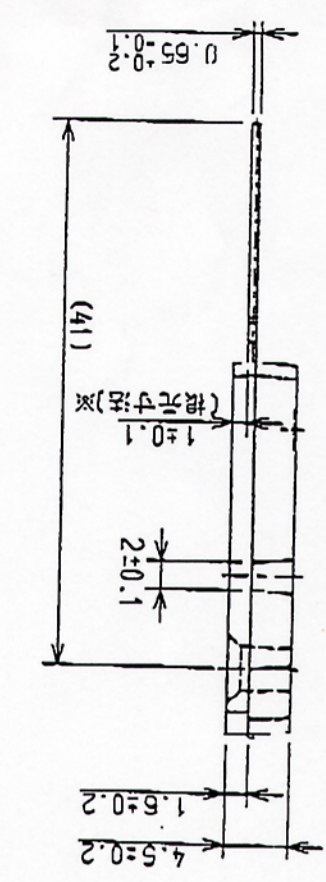
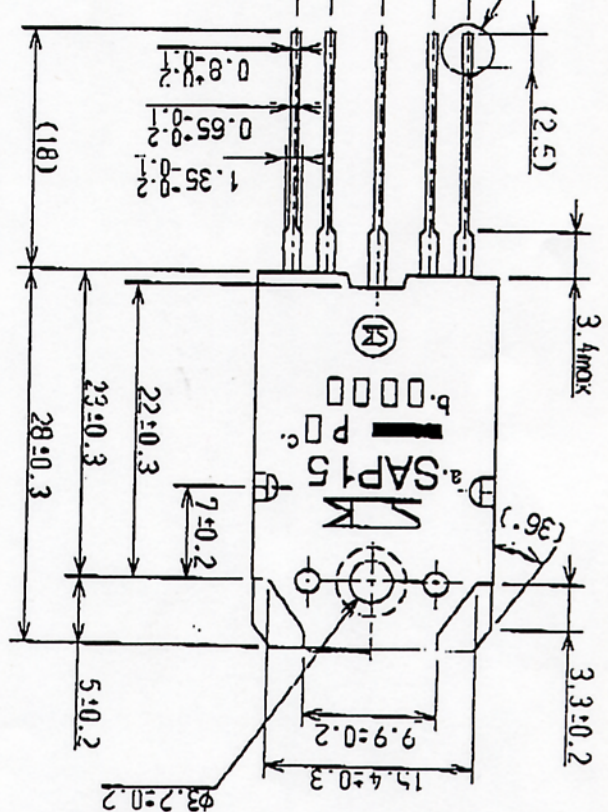
D1のTotal V_{BE} と T_r のTotal $V_{BE} + I_{tr}$ の抵抗の10% VR(測定条件は上記を適用) $\Delta V = 0-500mV$
When T_r is used for a pair, following conditions need to be satisfied. Total V_F of D1 & Total V_{BE} of T_r
Total V_F of Emitter Resistor (The above measurement conditions shall be applied) $\Delta V = 0-500mV$.

SSS-20733

2/4

Sanken SANKEN ELECTRIC COMPANY, LTD.

外形寸法図 LF550 Outline drawing of lead forming No.550



a. 品名番号
Type Number
b. ロット番号
Lot Number
c. 部品記号
Part Number

1st letter
第1文字
2nd letter
第2文字
Month
月
1 - 9月: 75 E7 数字
10月: O
11月: N
12月: D
(1 to 9 for Jan. to Sept., D for Nov. D for Dec.)
西暦年号下一桁
the last digit of year

1 - 9月: 75 E7 数字
10月: O
11月: N
12月: D
(1 to 9 for Jan. to Sept., D for Nov. D for Dec.)
西暦年号下一桁
the last digit of year

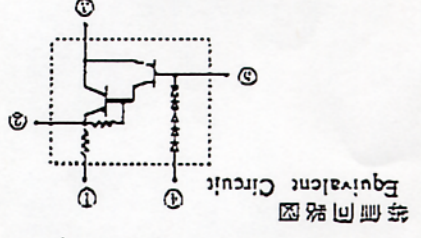
1st letter
第1文字
2nd letter
第2文字
Month
月
1 - 9月: 75 E7 数字
10月: O
11月: N
12月: D
(1 to 9 for Jan. to Sept., D for Nov. D for Dec.)
西暦年号下一桁
the last digit of year

01 - 31 Arabic numerals
01-31 アラビア数字
3rd & 4th letter Day
3rd & 4th letter Day
53, 4文字
53, 4文字
c. HFE 77
c. HFE 77
nFE rank
nFE rank

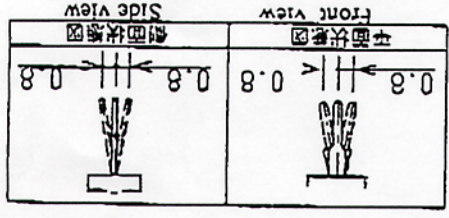
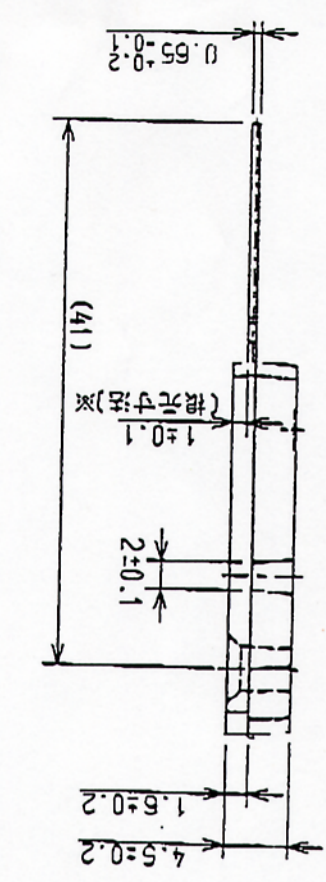
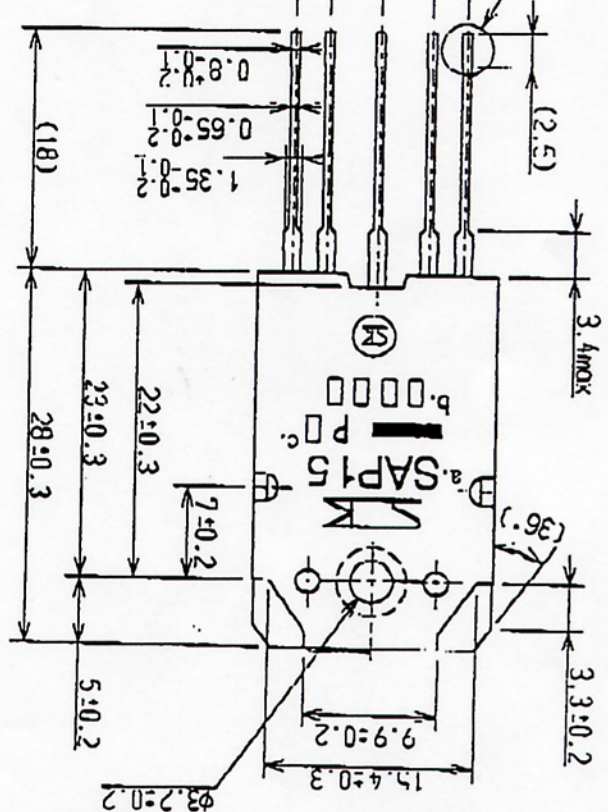
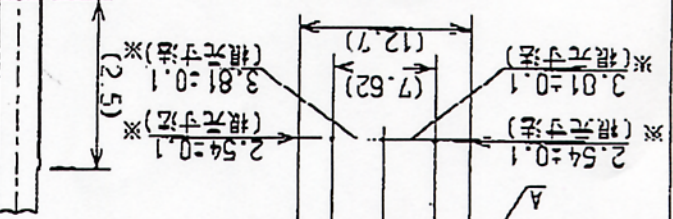
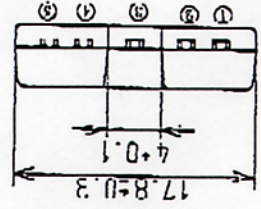
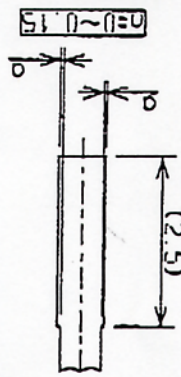
SSE-20733

4/4

※ Dimensions between roots
--- 部は高さ0.3maxのクートバリ発生箇所を示す。
(バリ発生箇所の勝手選り柄もあります)
shows a point where 0.3max gate burr is produced.
(The flash may appear at the opposite side)



Magnification of part A
A部拡大図: S=10/1



a. 品名番号
Type Number
b. ロット番号
Lot Number
c. 部品記号
Part Number

1st letter
第1文字
2nd letter
第2文字
Month
月
1 - 9月: 75 E7 数字
10月: O
11月: N
12月: D
(1 to 9 for Jan. to Sept., D for Nov. D for Dec.)
西暦年号下一桁
the last digit of year

1 - 9月: 75 E7 数字
10月: O
11月: N
12月: D
(1 to 9 for Jan. to Sept., D for Nov. D for Dec.)
西暦年号下一桁
the last digit of year

1st letter
第1文字
2nd letter
第2文字
Month
月
1 - 9月: 75 E7 数字
10月: O
11月: N
12月: D
(1 to 9 for Jan. to Sept., D for Nov. D for Dec.)
西暦年号下一桁
the last digit of year

01 - 31 Arabic numerals
01-31 アラビア数字
3rd & 4th letter Day
3rd & 4th letter Day
53, 4文字
53, 4文字
c. HFE 77
c. HFE 77
nFE rank
nFE rank

SSE-20733

4/4